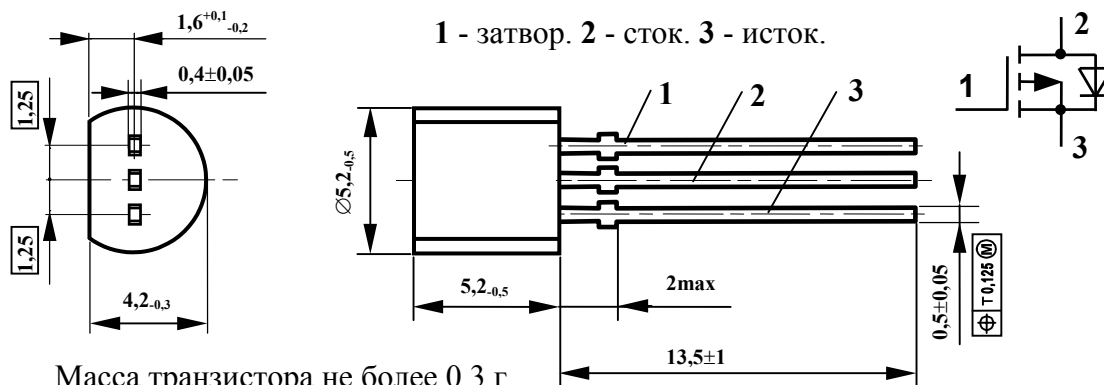


АДБК 432140.691 ТУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и Р-каналом предназначены для использования в источниках вторичного электропитания с бестрансформаторным входом, в регуляторах, стабилизаторах с непрерывным импульсным управлением, блоках питания ЭВМ, в схемах управления электродвигателями и другой радиоэлектронной аппаратуре.



Предельно допустимые режимы эксплуатации.

Параметры	Обозначение	Ед. изм	Значение
Ток стока*	$I_{с\ max}$	А	-1.1
Импульсный ток стока**	$I_{с\ и\ max}$	А	-4.4
Напряжение затвор-исток	$U_{зи\ max}$	В	± 20
Рассеиваемая мощность	P_{max}	Вт	1.0
Температура перехода	$T_{пер}$	°С	-55...150

Основные электрические параметры (Токр.ср. = 25°С).

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Режимы измерения	Min	Max
Пробивное напряжение	$U_{проб}$	В	$U_{зи} = 0, I_{с} = 250\ \mu A$	-50	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии*	$R_{си\ отк}$	Ом	$U_{зи} = -10V, I_{с} = -1.1A$		0.8
Пороговое напряжение	$U_{зи\ пор}$	В	$U_{зи} = U_{си}, I_{с} = 1.0mA$	-0.8	-2.0
Крутизна характеристики*	S	А/В	$U_{си} > 2.0V, I_{с} = 1.1A$	0.25	
Остаточный ток стока	$I_{с\ ост}$	мкА	$U_{си} = -50V, U_{зи} = 0$		-1.0
Ток утечки затвора	$I_{з\ ут}$	нА	$U_{зи} = 20V$ $U_{зи} = -20V$		100 -100
Входная емкость	$C_{вх}$	пФ	$U_{зи} = 0, U_{си} = -25V, f = 1MHz$		400
Выходная емкость	$C_{вых}$	пФ	$U_{зи} = 0, U_{си} = -25V, f = 1MHz$		230
Проходная емкость	$C_{прох}$	пФ	$U_{зи} = 0, U_{си} = -25V, f = 1MHz$		130
Прямое напряжение диода*	$U_{си}$	В	$U_{зи} = 0, I_{с} = 2.2A$		1.5
Постоянный ток диода	$I_{д}$	А			1.1
Импульсный ток диода**	$I_{д\ имп}$	А			4.4

- * При измерении должны быть следующие параметры импульсов: $t_i < 300\ \mu s$. $Q > 50$.
- ** Длительность импульсов ограничена максимальной температурой перехода.